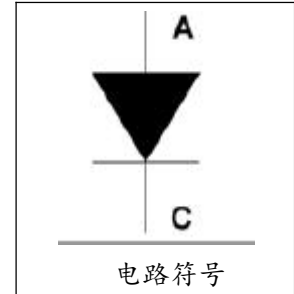


KD650

特点:

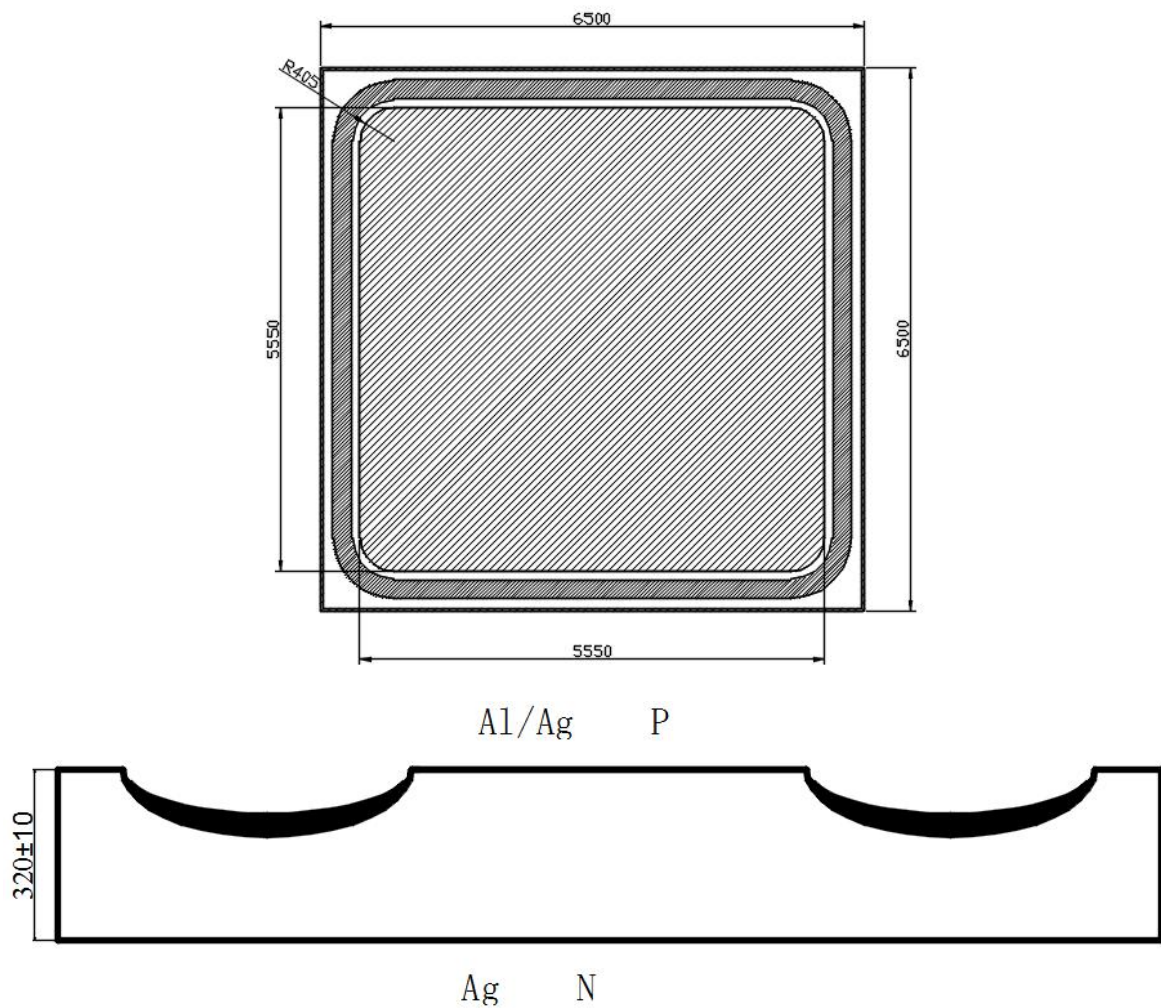
- 阻断电压高 (>2000V)
- 低导通压降; 高通态电流 I_{TSM}
- 复合钝化独立台面槽结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高



应用:

主要应用于各类电力电子模块。

外形尺寸图:



单位: 微米



极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{RRM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_R=0.1\text{mA}$	2000			V
V_{RSM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_R=0.1\text{mA}$	2200			V
$I_{F(AV)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	60			A
I_{FSM}	$T_j=45^{\circ}\text{C}$, $t=10\text{ms}$, $\sin 180^{\circ}$	740			A
T_j		-		150	$^{\circ}\text{C}$
TSTG		-		150	$^{\circ}\text{C}$

电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_R	$V_{RRM}=2000\text{V}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	5	μA
	$V_{RRM}=2000\text{V}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	1	mA
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_F=150\text{A}$	-	-	1.35	V
$V_{(TO)}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	0.9	V
R_T	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-		3	m Ω